

**Modulbezeichnung:** Crystal Growth ET (MWT 3) (CGET) 10 ECTS  
(Crystal growth ET)

Modulverantwortliche/r: Peter Wellmann

Lehrende: Peter Wellmann, Uwe Scheuermann

Startsemester: WS 2018/2019	Dauer: 2 Semester	Turnus: halbjährlich (WS+SS)
Präsenzzeit: 110 Std.	Eigenstudium: 190 Std.	Sprache: Deutsch

**Lehrveranstaltungen:**

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie (WS 2018/2019, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

Praktikum Wahlfach Crystal Growth (WS 2018/2019, Praktikum, 3 SWS, Peter Wellmann)

Elektronische Bauelemente und Materialfragen (Technologie II) (SS 2019, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

**Wahlvorlesungen**

Aus den optionalen Wahlveranstaltungen kann eine Vorlesung gewählt werden, die mit 1 ECTS in das Modul eingeht.

Halbleiter großer Bandlücke (SS 2019, optional, Vorlesung, 1 SWS, Peter Wellmann)

Aufbau- und Verbindungstechnik in der Leistungselektronik (WS 2018/2019, optional, Vorlesung, 2 SWS, Uwe Scheuermann)

Numerische Modellierung des Kristallwachstums mithilfe des Programmpakets COMSOL Multi-Physics (SS 2019, optional, Vorlesung mit Übung, 1 SWS, Anwesenheitspflicht, Peter Wellmann)

**Empfohlene Voraussetzungen:**

Bachelor in Materialwissenschaft, Nanotechnologie, Energietechnik, Physik, Chemie oder in einem vergleichbaren Studiengang.

**Inhalt:**

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie

- Grundlagen des Kristallwachstums
- Grundlagen der Silizium Halbleitertechnologie (Oxidation, Dotierung mittels Diffusion und Ionenimplantation, Ätzen, Metallisierung, Lithografie, Packaging)

Elektronische Bauelemente und Materialfragen

- Korrelation von Bauelementfunktion (Bipolar-Diode, Bipolar-Transistor, Schottky-Diode, Feldeffekt-Transistor, Leucht- und Laserdiode) mit Materialeigenschaften
- Grundlagen Epitaxie

Praktikum

- Czochralski Kristallwachstum von InSb
- Halbleitercharakterisierung

Vorlesung / Übung

- Computersimulation der Kristallzüchtung

**Lernziele und Kompetenzen:**

Die Studierenden

- erwerben fundierte Kenntnisse über Materialeigenschaften und deren Anwendungen in elektronischen Bauelementen

-lernen experimentelle Techniken in den Werkstoffwissenschaften kennen und können sie selbständig anwenden

- können in Gruppen kooperativ und verantwortlich arbeiten

**Literatur:**

- S.M. Sze; Semiconductor Devices - Physics and Technology (14 x T80/8S58(2))
- P.J. Wellmann; Materialien der Elektronik und Energietechnik : Halbleiter, Graphen, funktionale Materialien; Springer Vieweg (2017), eBook ISBN 978-3-658-14006-9, DOI 10.1007/978-3-658-14006-9, Softcover ISBN 978-3-658-14005-2

Buch: T80/10 T 19

elektronisch: <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-14006-9>

---

### Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar:

[1] **Energietechnik (Master of Science)**

(Po-Vers. 2011 | TechFak | Energietechnik (Master of Science) | Module M2 - M5 und M9 (Kern- und Vertiefungsmodule, gegliedert nach Studienrichtungen) | Studienrichtung: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik | M4+M5 Studienrichtungsspezifisches Vertiefungsmodul A+B | MWT3: Werkstoffwissenschaftliche Vertiefungsmodule)

[2] **Energietechnik (Master of Science)**

(Po-Vers. 2015w | TechFak | Energietechnik (Master of Science) | Gesamtkonto | Studienrichtung Materialwissenschaften und Werkstofftechnik | Modulgruppe Materialwissenschaften und Werkstoffkunde | MWT3)

[3] **Energietechnik (Master of Science)**

(Po-Vers. 2018w | TechFak | Energietechnik (Master of Science) | Gesamtkonto | Studienrichtung Materialwissenschaften und Werkstofftechnik | Modulgruppe Materialwissenschaften und Werkstoffkunde | MWT3)

---

### Studien-/Prüfungsleistungen:

Crystal Growth ET (MWT 3) (Prüfungsnummer: 991457)

(englische Bezeichnung: Crystal growth ET)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 30

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%

weitere Erläuterungen:

zusätzlich Absolvierung des Praktikums!

Erstablingung: WS 2018/2019, 1. Wdh.: SS 2019

1. Prüfer: Peter Wellmann